

## 酸化・拡散炉



装置全景



ガス導入部

### 【主な仕様】

- ・酸化方式:ドライ(酸素), ウェット(水蒸気)
- ・基板サイズ:4インチ  
4インチ以下でご利用の場合には, 別途, 石英の治具(ボート)をご準備ください。
- ・炉内温度:最高1100℃

### 【その他】

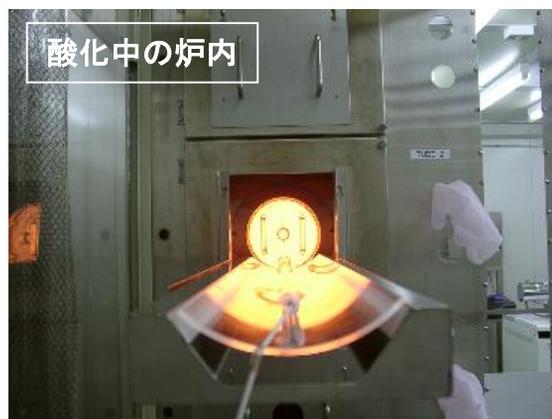
- ・現在, 拡散工程がご利用いただけません。
- ・基板の取り出しは, ご利用いただいた次の日となります。

### 機種名

大和半導体 TM7800-4  
2005年度購入

### 特徴

- ドライ方式またはウェット方式で, 熱酸化シリコン膜をシリコン基板上に成膜できます。
- 炉内温度, 酸化時間と膜厚の例  
ドライ方式  
1000℃, 2時間一約 70nm  
ウェット方式  
1100℃, 2.5時間一約100nm



酸化中の炉内

### 料金等

施設開放:2,500 円/ 時

操作法説明: 11,700 円(3時間)

※その他、基礎～応用まで別途相談承ります。

研究員による支援

3,900 円 / 時

試作の支援・指導

機器操作など

ご利用申し込みは実施日の3日前まで可能です。